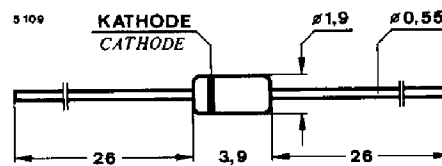


## Silizium-Epitaxial-Planar-Diode Silicon epitaxial planar diode

**Anwendungen:** Allgemein

**Applications:** General purpose

**Abmessungen in mm  
Dimensions in mm**



Normgehäuse  
Case  
54 A 2 DIN 41 880  
JEDEC DO 35  
Gewicht · Weight  
max. 0,15 g

### Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	$U_{RRM}$	60	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	$U_R$	50	V
Stoßdurchlaßstrom <i>Surge forward current</i> $t_p \leq 1 \mu s$	$I_{FSM}$	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom <i>Repetitive peak forward current</i>	$I_{FRM}$	450	mA
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	$I_F$	200	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert <i>Average forward current</i>	$I_{FAV}$	150	mA
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	$t_j$	200	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	$t_{stg}$	-65...+200	°C

# BA 204

## Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung  
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$ ,  $t_L = \text{konstant}$   
constant

$R_{thJA}$

350 °C/W

## Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25 \text{ °C}$ , falls nicht anders angegeben  
unless otherwise specified

Durchlaßspannung  
Forward voltage

$I_F = 100 \text{ mA}$

$U_F^{1)}$

1 V

Sperrstrom  
Reverse current

$U_R = 30 \text{ V}$

$U_R = 30 \text{ V}$ ,  $t_j = 150 \text{ °C}$

$I_R$

100 nA

$I_R$

100  $\mu\text{A}$

Durchbruchspannung  
Breakdown voltage

$I_R = 1 \text{ }\mu\text{A}$

$U_{(BR)}$

50

V

Diodenkapazität  
Diode capacitance

$U_R = 0$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$

$C_D$

5 pF

Rückwärtserholzeit  
Reverse recovery time

$I_F = I_R = 10 \text{ mA}$ ,  $i_R = 1 \text{ mA}$

$t_{rr}$

10 ns

<sup>1)</sup>  $\frac{t_p}{T} = 0,01$ ,  $t_p = 0,3 \text{ ms}$

